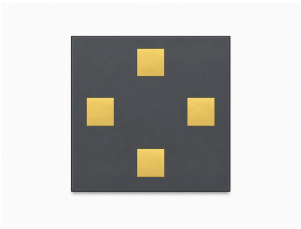
DC–40000 MHz Die incrocio RF GaAs

LCXOV-DC-40000-D — DC–40000 MHz Die incrocio RF GaAs.

Perdita di inserzione: 0.4 dB (tipico); Isolamento: 30 dB (tipico); Perdita di ritorno: 20 dB (tipico). Dimensioni del die: 0.6 × 0.6 × 0.1 mm.



Caratteristiche RF

TA = +25 °C

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Valore	Unità
Frequenza operativa	-	0	-	40000	DC–40000	MHz
Perdita di inserzione	-	-	0.4	-	-	dB
Isolamento	-	-	30	-	-	dB
Perdita di ritorno	-	-	20	-	-	dB

Valori limite

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Potenza di ingresso massima	-	-	-	35	dBm

Condizioni ambientali

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Temperatura di stoccaggio	-	-65	-	150	°C
Temperatura operativa	-	-55	-	125	°C

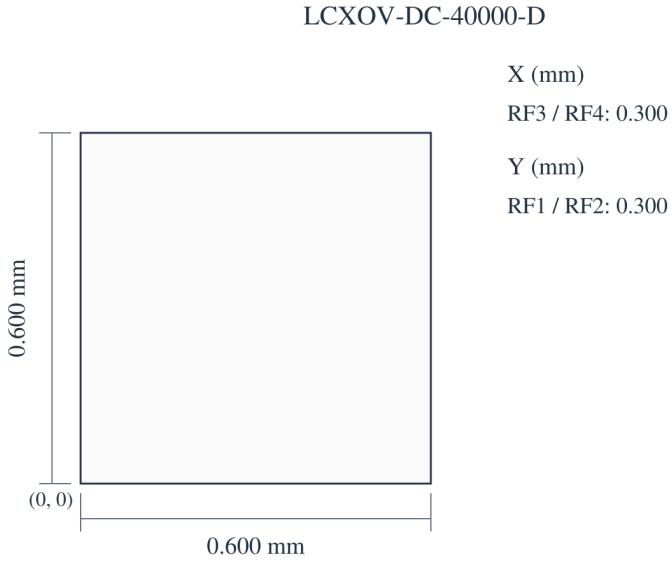
Assegnazione delle piazzole di bonding

Terminali	Simbolo	Funzione	Note
RF1	RF1	Porta RF	-
RF2	RF2	Porta RF	-
RF3	RF3	Porta RF	-
RF4	RF4	Porta RF	-

Dimensioni del die

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni del die	0.6 × 0.6 × 0.1	mm

Disegno di riferimento con alcune quote in mm. Per la fabbricazione e il wire bonding occorrono i disegni completi.



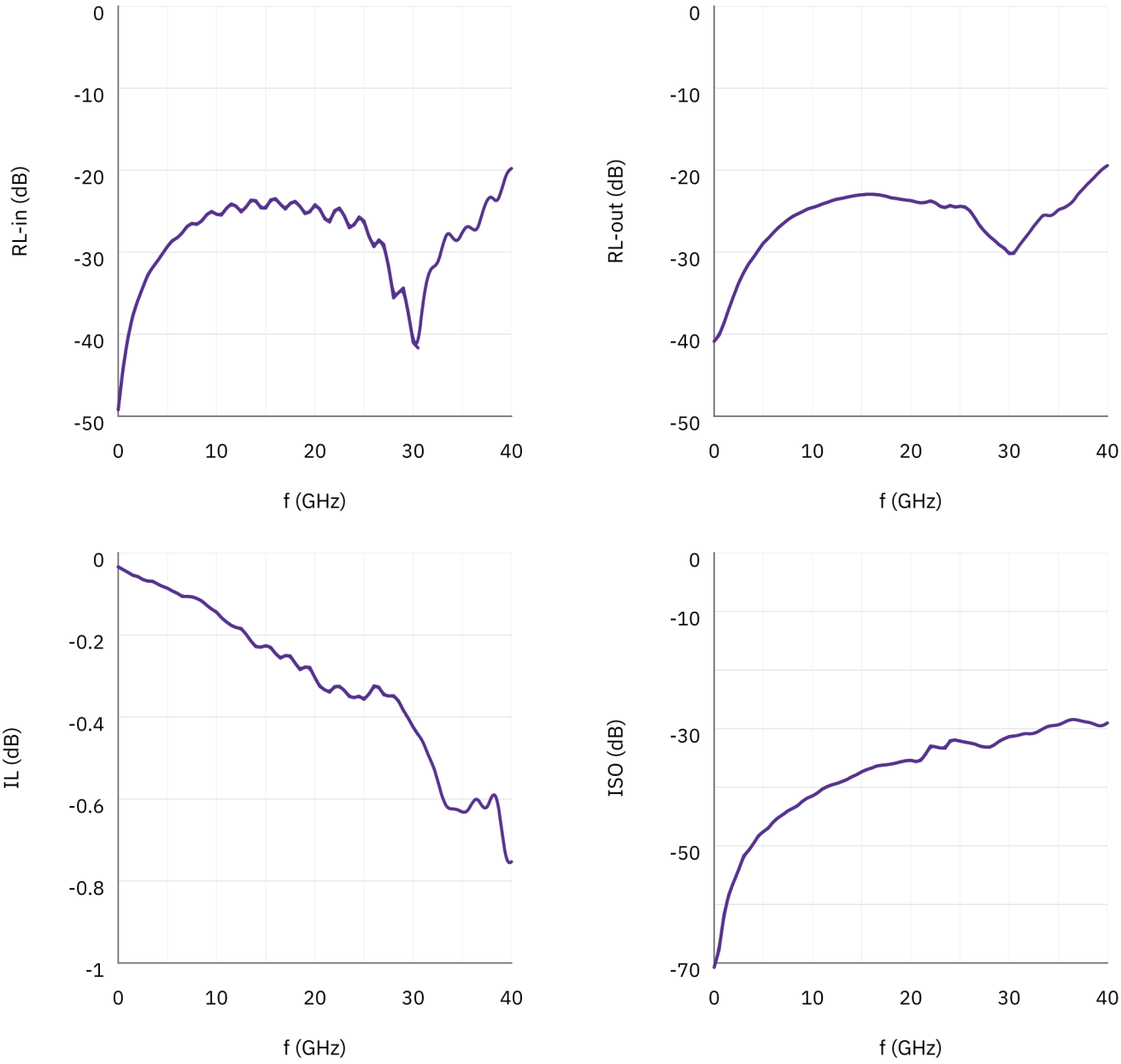
Pubblicazione corrente · 1.6 · 2026-11-12. Aggiornamento della descrizione o dei contenuti editoriali. Sostituisce la revisione 1.5.

Curve di prestazione

Consultare ogni figura insieme alle condizioni operative indicate.

Adattamento d’ingresso; Adattamento d’uscita; Perdita di inserzione; Isolamento.

Note della figura: TA=+25°C. I valori letti sono approssimativi. Le perdite di ritorno in ingresso e in uscita e l’isolamento sono rappresentati con segno in dB.



Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L’offerta approvata e la documentazione d’ordine definiscono la configurazione fornita.